

株式会社ジェイ・イー・ティ

2025年12月期第2四半期（中間期）
決算説明会資料

2025年8月25日

1. 2025年12月期 第2四半期（中間期）決算概況
2025年12月期 通期予想
2. 決算修正を受けた経営戦略の見直しについて

Appendix

1. 2025年12月期第2四半期（中間期） 決算概況 2025年12月期通期予想

業績サマリー

中国ファウンドリ向け及び日本向け洗浄装置の売上遅延などを受け減収
中国市場での利益率の低い装置、カスタマイズ要素多い新規案件などの計上や
受注したが納入時期が明確でない製品の棚卸評価損計上の要因大きく減益

売上高 7,280百万円 前年同期比 ▲27.0%	営業利益 ▲1,637百万円 前年同期比 —	経常利益 ▲1,705百万円 前年同期比 —	純利益 ▲2,450百万円 前年同期比 —
---	--	--	---

- ✓ 中国国内での米国通商政策（関税措置）による混迷や不動産不況・米中対立に端を発する消費低迷など深刻化する中国経済の停滞、地政学的なリスクの継続など不透明な状況が継続
- ✓ エレクトロニクス製品の世界的な消費停滞は継続、特に中国市場ではここ数年間の成熟世代半導体向け新規設備投資増強の影響を受け、ファウンドリの設備稼働率は停滞
- ✓ メモリーもDRAM及びNANDフラッシュの価格は緩やかに上昇、AIサーバー向けGPUとHBMの需要は引き続き旺盛、投資も継続

売上高の減少に加え、一過性の要因（棚卸評価損の計上など）も重く赤字転落
純利益については繰延税金資産取り崩しの7億60百万円もあり、24億50百万円の赤字に

単位（百万円）	2024年12月期 中間期	売上比（%）	2025年12月期 中間期	売上比（%）	対前期比（%）
売上高	9,968	—	7,280	—	△27.0%
売上総利益または 売上総損失	2,006	20.1%	△295	—	—
販管費	1,418	14.2%	1,342	18.4%	△5.4%
営業利益または 営業損失	587	5.9%	△1,637	—	—
経常利益または 経常損失	520	5.2%	△1,705	—	—
中間純利益または 中間純損失	297	3.0%	△2,450	—	—

連結貸借対照表

増加・滞留していた「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」の評価損を計上

単位（百万円）	2024年12月期	2025年12月期 中間期	増減	主な増減要因
流動資産	23,824	20,750	△3,073	「商品及び製品」「仕掛品」 「原材料及び貯蔵品」の減少
有形固定資産	831	800	△31	
無形固定資産	101	107	6	
投資その他資産	734	118	△616	「繰延税金資産」の減少
資産合計	25,491	21,776	△3,715	
流動負債	8,575	7,530	△1,045	「短期借入金」の減少
固定負債	4,446	4,365	△81	「長期借入金」の減少
負債合計	13,021	11,895	△1,126	
純資産合計	12,469	9,881	△2,588	「利益剰余金」の減少
負債純資産合計	25,491	21,776	△3,715	

売上高・経常利益推移

売上構成

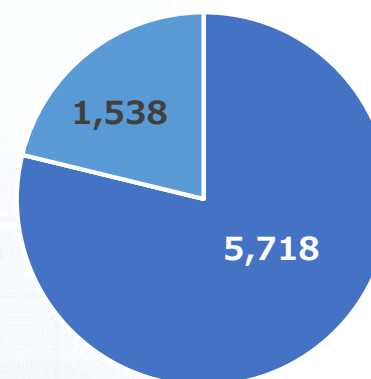
経常利益は赤字転落

セグメント別連結売上高

売上高・経常利益推移



半導体事業内訳

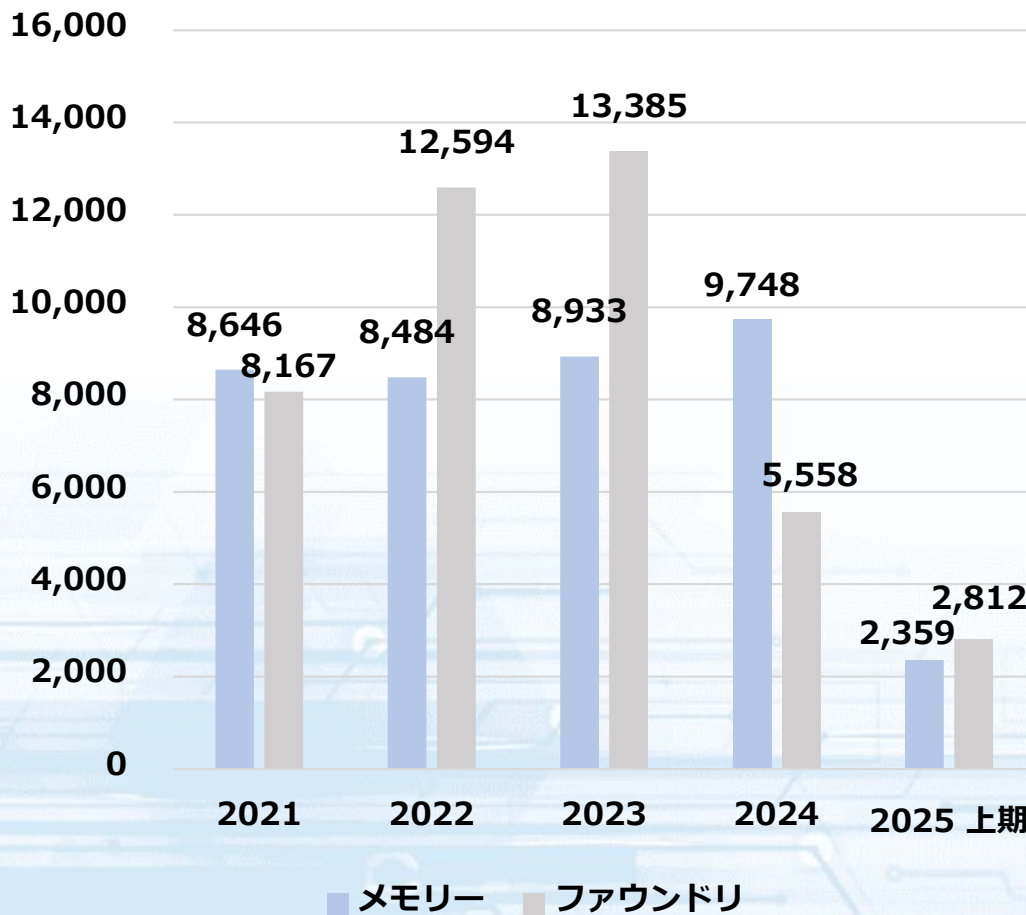


■ バッチ式 ■ 工事・部品他

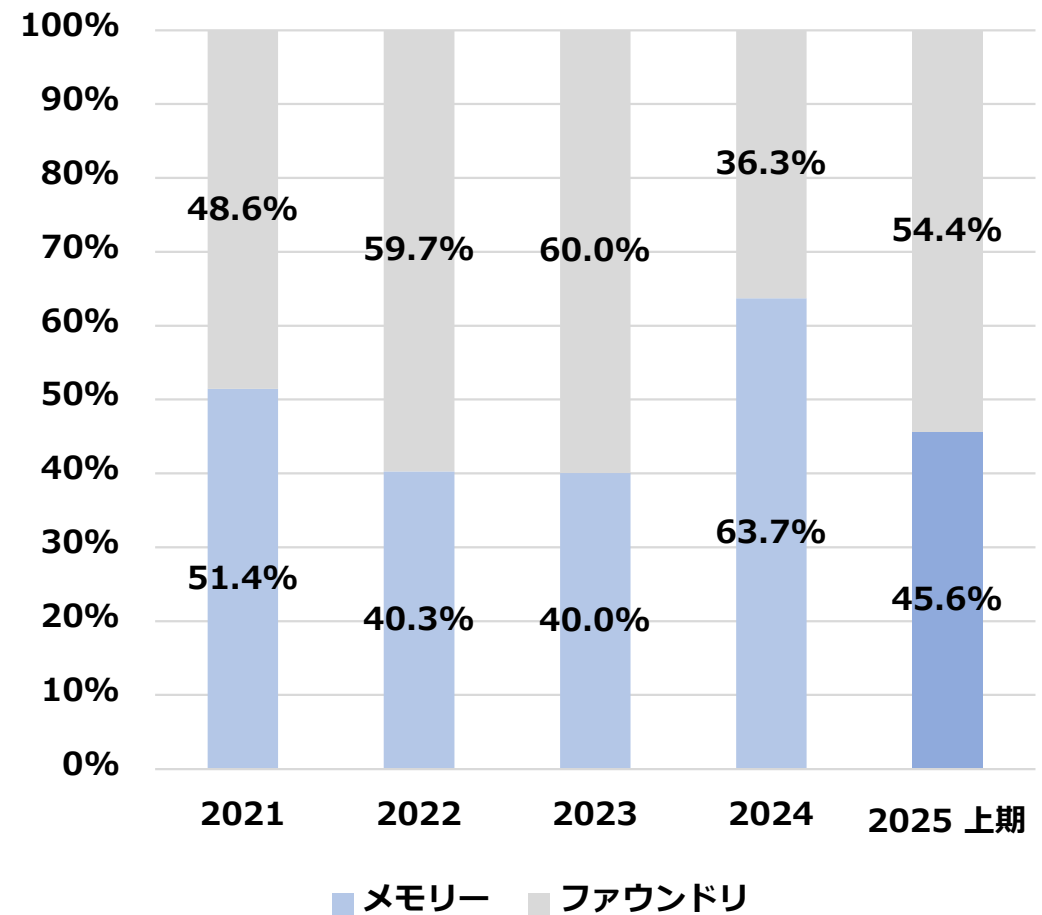
2025年12月期
上期実績

装置売上高推移（仕向け先別）

装置売上高仕向け先別推移

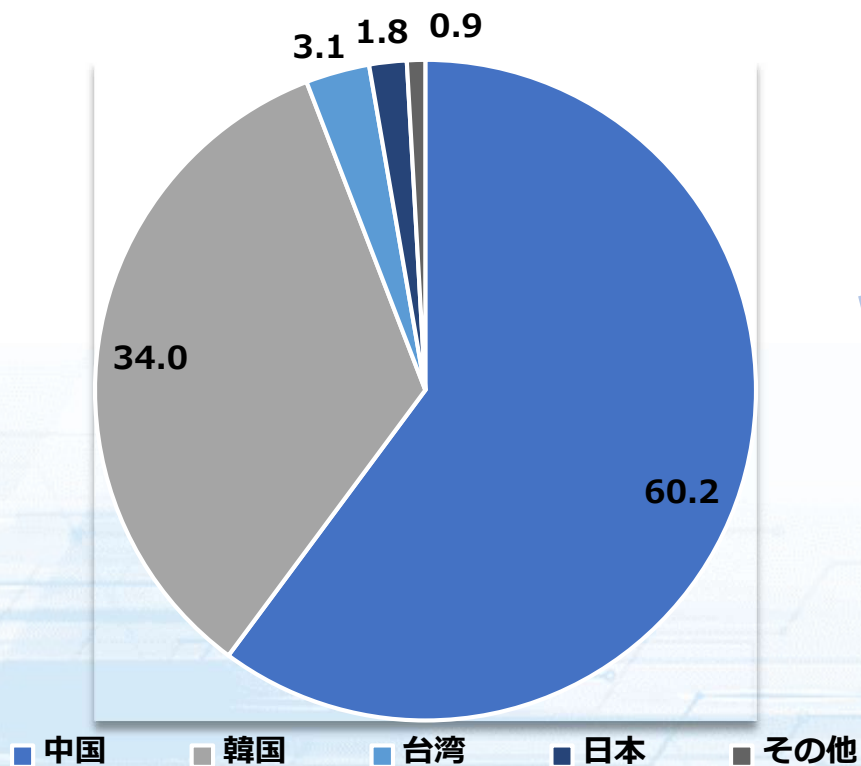


装置売上高仕向け先別構成比推移

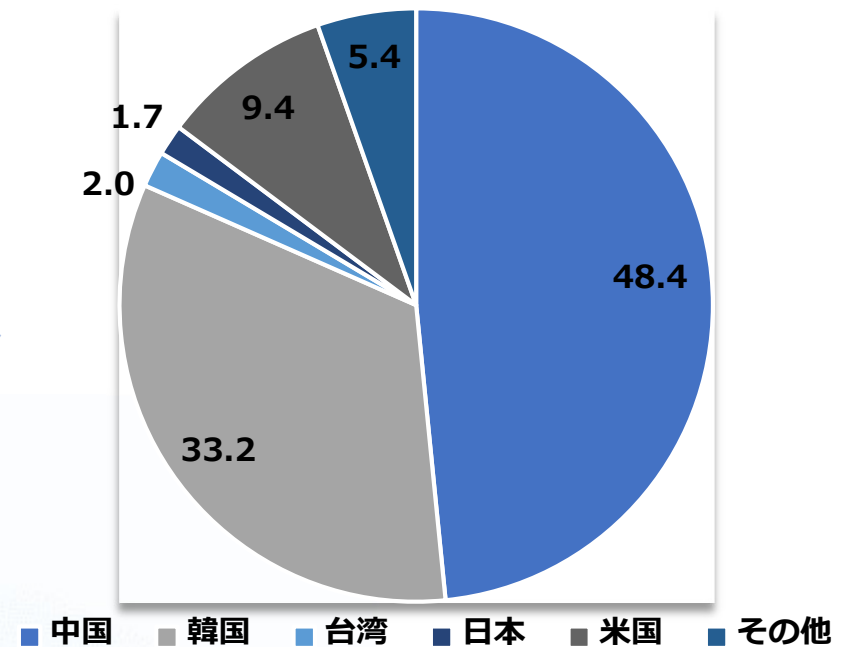


地域別売上高構成比推移① 前期比較

米国市場にて売上計上（売上構成比率9.4%）



2024年12月期 単位%



2025年12月期 中間期 単位%

米国子会社 インターポーザ洗浄装置売上

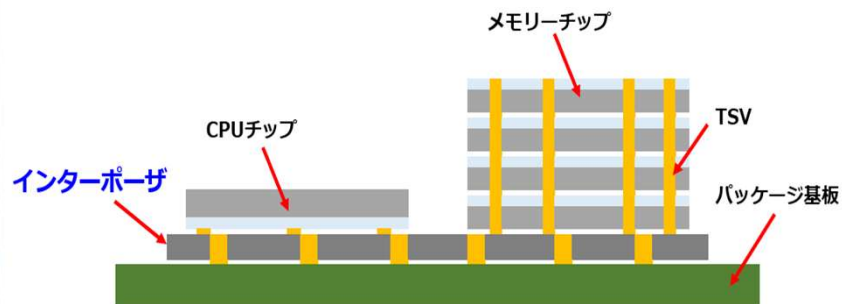
テキサス・インスツルメンツ（TI）などが本社を置く
テキサス州に米国子会社JET AMERICA INC.を2024年1月設立
レガシー領域顧客の開拓を始める一方、
半導体チップと基板を電氣的に接続する「インターポーザ」向け
洗浄装置を受注、出荷、2025年6月には現地納品、立上を完了

インターポーザ (配線回路基板)

「間に挟む」を意味するラテン語が
起源

半導体チップをレゴブロックのよう
組み合わせる技術（チップレット）
において、中継部材として極めて需
要な役割を果たす部材

AI半導体の先進パッケージング
の基本構造になる2.5Dや3Dパッ
ケージに欠かせない

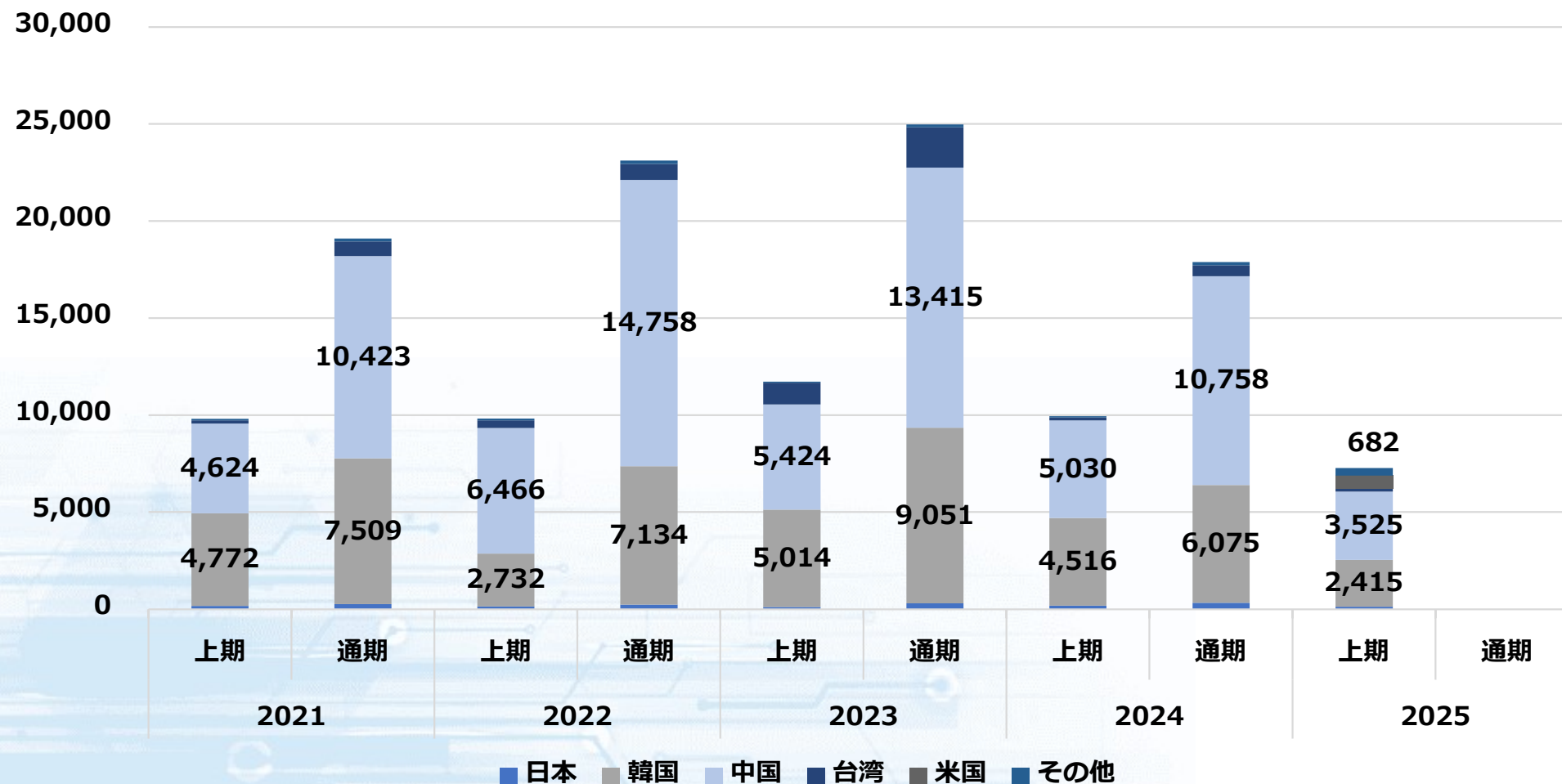


JET AMERICA INC.

地域別売上高構成比推移②

米国の売上 6 億82百万円

今後、一層の市場開拓に注力



マクロ環境については厳しい環境が続くも、生成AIの利用拡大、DXの進展などデータ社会への移行により、緩やかな改善もみられる

- ✓ 米国の関税措置について日本、韓国、EUなど各国合意はなされたが、なお合意項目の確認や当初提示された税率からは軽減されたものの、相応の税率が付されることが世界経済に与える影響は不透明
- ✓ 米中貿易摩擦や不動産不況に端を発する中国経済の停滞懸念は持続
- ✓ データ社会への移行が進む中、先端半導体のニーズは更に高まっている
- ✓ 車載や産業向けのレガシー半導体の需要は軟調ではあるが、緩やかに改善

2025年12月期通期業績予想①

通期業績予想を修正

今期は赤字決算に

売上高
13,420百万円

前期比 ▲24.9%

営業利益
▲1,810百万円

前期比 ー

経常利益
▲1,910百万円

前期比 ー

当期純利益
▲2,750百万円

前期比 ー

減収要因

- 韓国メモリーメーカー、中国ファウンドリ向け洗浄装置の立上が来期にずれ込み
- 中国ファウンドリ及びメモリーメーカーから受注を想定していた装置の投資計画が延期に

2025年12月期通期業績予想②

受注したが納入時期が明確でない製品の在庫を棚卸評価損として整理

減益要因

- 2025年上期に想定していた中国市場向け案件が受注に至らず、売上高が大きく減少
- 中国市場での現地メーカーと競合の上受注した利益率低い装置の売上計上
- 13億40百万円に及ぶ製品在庫の棚卸評価損の計上
- 2億円に及ぶ部品在庫の棚卸評価損の計上
- 繰延税金資産の取り崩しに伴う法人税調整額の計上（7億60百万円）

2. 決算修正を受けた経営戦略の見直しについて

長期連結業績（売上高・営業利益）推移

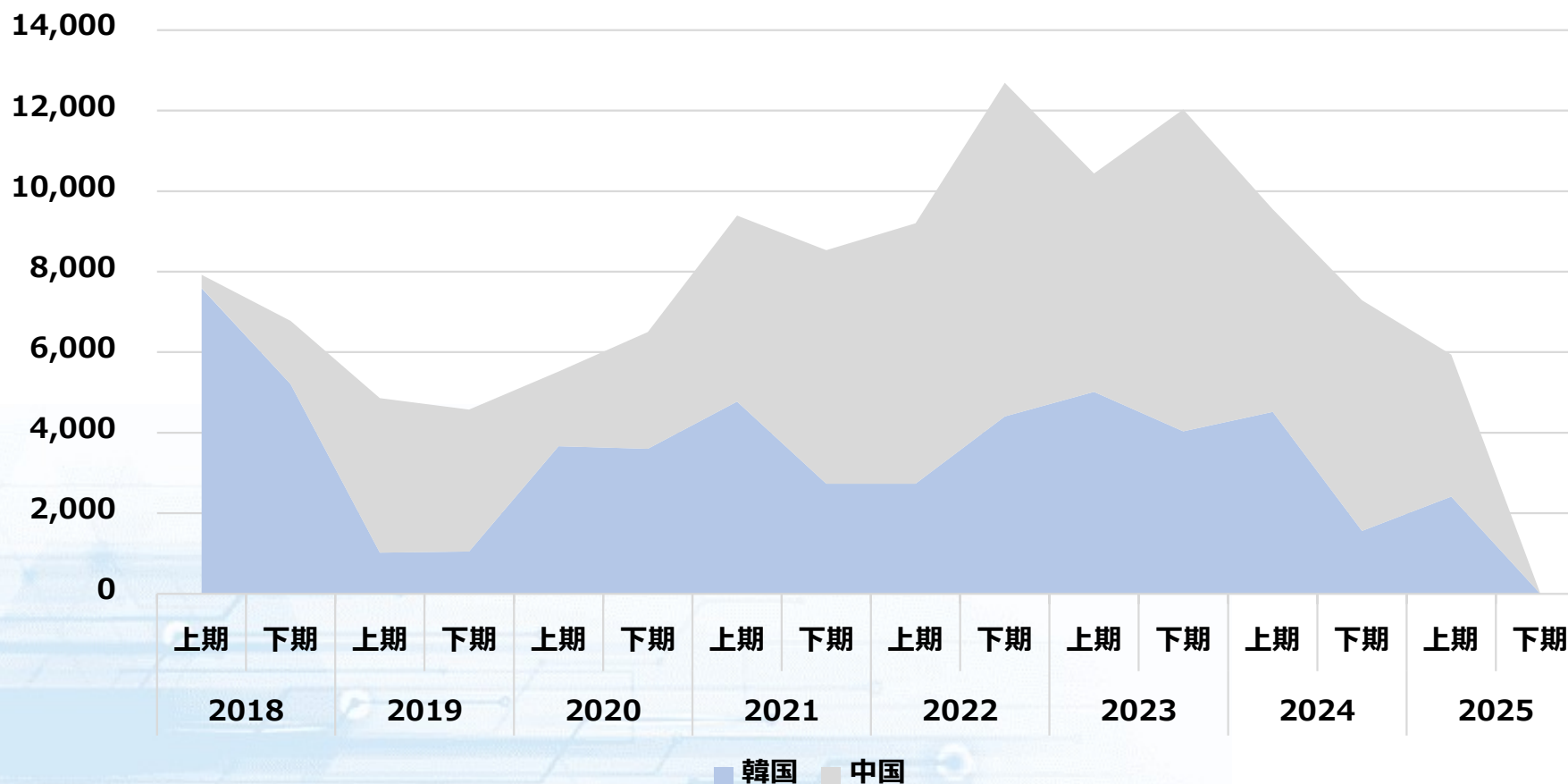
今回の修正により、売上高、営業利益とも2020年の水準に低迷
営業利益は2012年以来の赤字に



* 2019年以前の数字は監査法人による監査を受けていない参考数字

中国・韓国売上高 上下推移

2021年から2023年の業績を牽引したのは中国市場
その中国市場の変調や競争環境の激化が2024年下期以降の苦戦の原因



	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
韓国	7,594	5,208	1,024	1,046	3,667	3,602	4,772	2,737	2,732	4,402	5,014	4,037	4,516	1,559	2,415	
中国	330	1,568	3,832	3,528	1,856	2,899	4,624	5,799	6,466	8,292	5,424	7,991	5,030	5,728	3,525	

中国市場の現状と今後の打ち手

- 米中対立のなか、半導体産業の自立を志向し国策として近年、育成を強化
- 特に成熟世代半導体向けに旺盛な新規設備投資が行われた
- 急激な設備増強の反動として設備稼働率が低下し、投資計画の延期などが顕在化
- 洗浄装置領域でも新興の中国メーカーが国家の後押しもあり台頭、競合が激化
- 現状、新興の中国メーカーは中国市場だけでなく世界市場への進出を検討

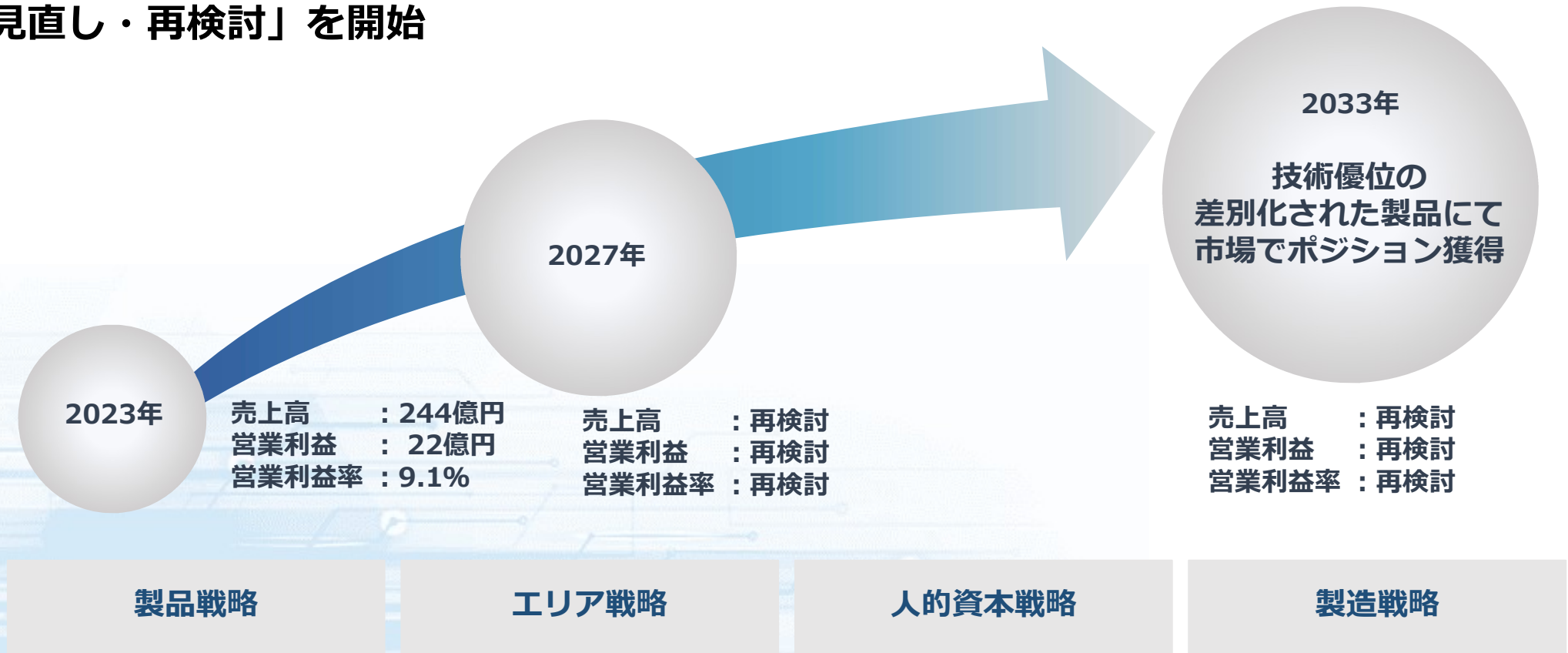


- 当社はバッチ式について主力機種BW3000から後継機種BW3500 への切り替えに注力
- BW3500は今後投資の中心になる28nm以上のプロセスをターゲットに、現地メーカーに対して技術優位性を持ち、日系他社製品からの切り替えも意識した戦略機種
- 現状、中国でも引き合い対応中ながら、政治的な圧力も背景に中国新興メーカーの脅威に押されている

- BW3500の営業を進めながらも、自社単独ではなく、柔軟な発想にて他社との協業・連携も模索し、中国製装置としての現地生産を目指す

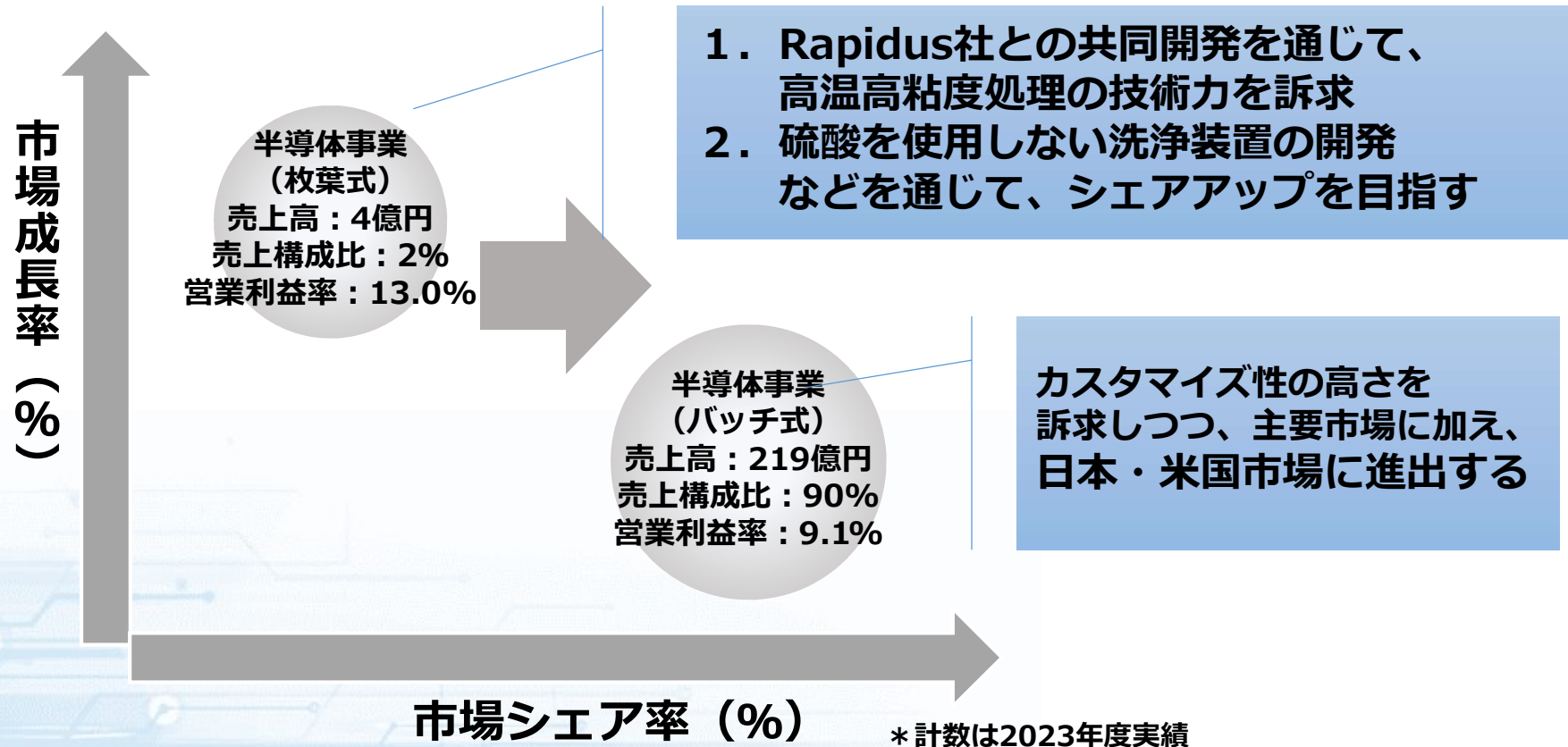
中長期経営戦略の見直し

市場環境を冷静に見つめた今回の決算修正を受け、
数値目標と4つの軸「製品戦略」「エリア戦略」「人的資本戦略」
「製造戦略」について大きな戦略の方向性は変わらないものの現況を踏まえた
「見直し・再検討」を開始



事業ポートフォリオ整理

バッチ式のシェアを守りつつ、差別化された枚葉式洗浄装置で成長を期す方向性は不変



- バッチ式洗浄装置は、今後も一定の市場規模を維持しつつ、半導体市場の成長に伴い緩やかに市場成長する見通し
当社は世界シェア11%を占めており、今後も市場シェア率の拡大を目指す
- 枚葉式洗浄装置は、今後も主要な洗浄装置である可能性が高く、半導体の市場の成長に伴い大きく市場成長する見通し
当社は高温高粘度処理に対応した枚葉式洗浄装置の開発・販売を通じて、市場シェアの拡大を目指す

Rapidus社との共同開発 量産機 1 台を納入

- ・ Rapidus社はIBM社と戦略的パートナーシップを締結し、2 nm半導体の開発・生産を目指す
- ・ Rapidus社は多品種少量生産で「どこよりも速い」半導体製造の実現を目指し、全枚葉式を軸としている
- ・ 製造装置は基本的にIBM社ラインの装置が導入されるが、リン酸エッチング処理についてはIBM社ラインに枚葉式がなく、別途開発が必要となっている
- ・ 研究開発段階（α機）を終え、試作装置製作に関する研究開発（β機）段階だったが、2025年7月に量産機1台を納入
- ・ 引き続き、当社は2027年量産ラインへの対応を進める。



Rapidus千歳工場（IIM）
2023年9月起工
2025年4月試作ライン稼働、
2025年7月
2nm半導体の試作品を公開
2027年量産ライン立ち上げ予定

当社 枚葉式装置のプロセス種類

薬液種類	JET装置	イメージ	機能と性能
SPM(H₂SO₄) 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	HTS HTS-300		薬液使用量の削減 ・プロセス時間の大幅短縮により薬液使用量は他社の20分の1にまで削減 ・ヒータによる温度制御によって高いレジスト除去性能を実現 効率的な処理が可能に ・除去したレジストは重力で落下するため、パーティクル軽減
O₃ GAS 高ドーズインプラント後のレジスト除去 P-SiNドライエッチング後のレジスト除去	EcO₃ OMR-3000		環境への負荷が少なく、ランニングコストも低い ・枚様式SPM装置の構造を生かし、O₃ GASでの処理を実現 ・O₃ GASを使用することで環境負荷を軽減しながらSPM同様のプロセスが可能 ・酸とアルカリによる反応生成物が形成されないため、1つの処理モジュールでSC1処理可能
HP(H₃PO₄) Front side SiN除去	Rush HPR-3000		枚葉装置初の高温高エッチングレート処理 ・JETの特許技術を活用し、最先端の窒化膜処理を枚葉式装置で実現 ・高いウェハ均一性を実現 ・高温維持により、高いエッチングレートを実現
HP(H₃PO₄) Back side SiN除去	Rush HBE-3000		

製品戦略の方向性は不変

再検討は行うものの、
当社の技術優位性を生かした枚葉式洗浄装置の開発に注力する方向は変わらず

新HTS

1. 硫酸以外のプロセス対応
2. 薬液（プロセス）別製品型式対応
3. リン酸は日本での実績を → 横展開
4. 03（オゾン）は、新規引合いに対応中

2033年

技術優位の
差別化された製品にて
市場でポジション獲得

新工場の建設延期と本社工場の改築①

補助事業の 背景・目的

① 生産能力の問題：

増改築を繰り返してきた本社工場が手狭になってきており、生産能力が不足しつつある

② 生産性の問題：

- ・ 洗浄装置 1 台製造するのに必要な部品は 2 ～ 3 万点。生産数の増加に伴い、従来の人力による部品の保管・管理・ピッキングでは非効率となっている
- ・ 本社工場で部品保管する場所が不足し外部倉庫を賃貸、コスト増加に繋がっている

③ 研究開発の問題：

薬液の対応等が実験機 1 台分しかなく、同時並行で実験を行えない
(顧客対応や開発スピード遅滞の原因)



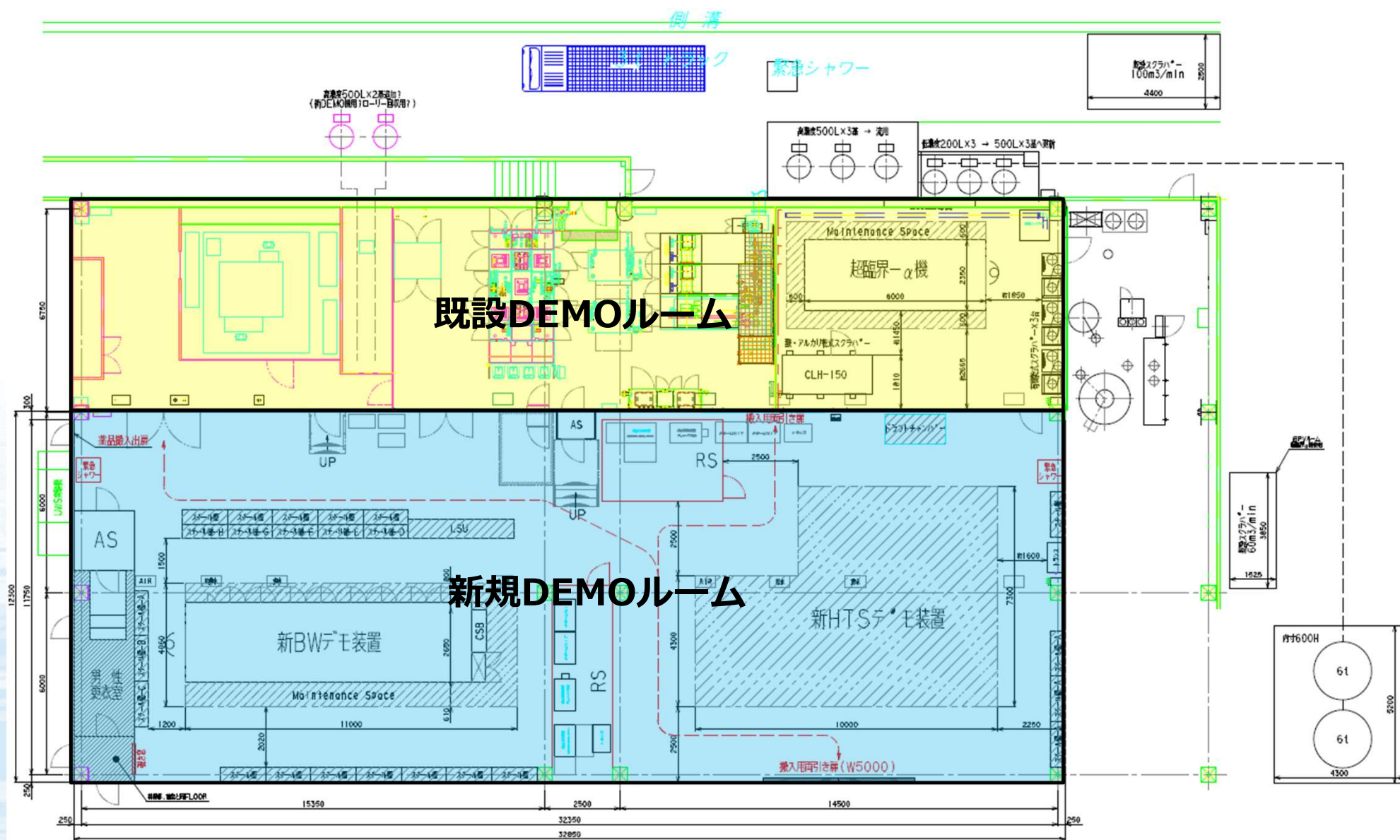
- 上記課題解決のため新工場の建設を企図
- 経済産業省の「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金事業」に採択
- 現本社に隣接する浅口市で用地を確保も、現状を鑑み新工場建設は継続検討
- ただし課題③や顧客向けのデモなどに対応するため、現工場の増改築を決定
- 増改築自体が補助金採択事業に該当

新工場の建設延期と本社工場の改築②

増改築範囲

目 的	具体的内容		主幹部門	スケジュール
① 顧客要求DEMOへの迅速な対応、信憑性向上 ② 新製品開発加速	C/R 14&15 Booth DEMOルーム化		技術開発部 (総務部)	2026年下旬を目途に調整中
	DEMO用力増強	コンプレッサー増設		
		純水設備増設		
		スクラバー増設		
		廃液処理設備増設		
	新BW DEMO装置導入		SD部 (SE部、調達部)	
新HTS DEMO装置導入				
③ 職場環境の改善 (老朽化対策)	雨漏り対策		総務部	
④ 設備補強 (老朽化対策)	搬入・搬出口ホイスト入替		調達部 (総務部)	

新工場の建設延期と本社工場の改築③



Appendix

会社概要

半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービスを展開



リーマン・ショック後の半導体不況時に民事再生手続を開始し、その後破産手続に移行したエス・イー・エス(株)が前身同社の卓越した半導体洗浄装置に関する技術を継承すべく、販売代理店であった韓国企業のZEUS CO., LTD.（以下、「ZEUS」）の全額出資のもと、2009.4.24に設立、2009.5にエス・イー・エス(株)の岡山工場等を事業譲渡により引き継ぎ誕生

■会社概要

会社名	株式会社ジェイ・イー・ティ
-----	---------------

英訳名	J.E.T. Co., LTD.
-----	------------------

設立	2009年4月
----	---------

資本金	1,848百万円（2024年12月31日時点）
-----	-------------------------

所在地	岡山県浅口郡里庄町新庄金山6078番
T E L	0865-69-4080

代表者	代表取締役 CEO 房野 正幸
-----	-----------------

従業員数	163名
従業員数	279名 ※連結会社含む全従業員数 (2025年6月30日時点)

事業内容	半導体洗浄装置の開発・製造・販売・アフターサービス等
------	----------------------------

主要納入先	サムスン電子（韓国）SMIC（中国）
-------	--------------------

グループ関係図

親会社ZEUSとは事業の棲み分けがなされ、競合関係もなく、経営についても役職員の出向等の受け入れを廃止し独立性の確保を図る



所在地： 大韓民国
京畿道華城市

資本金： 15,530,995千KRW

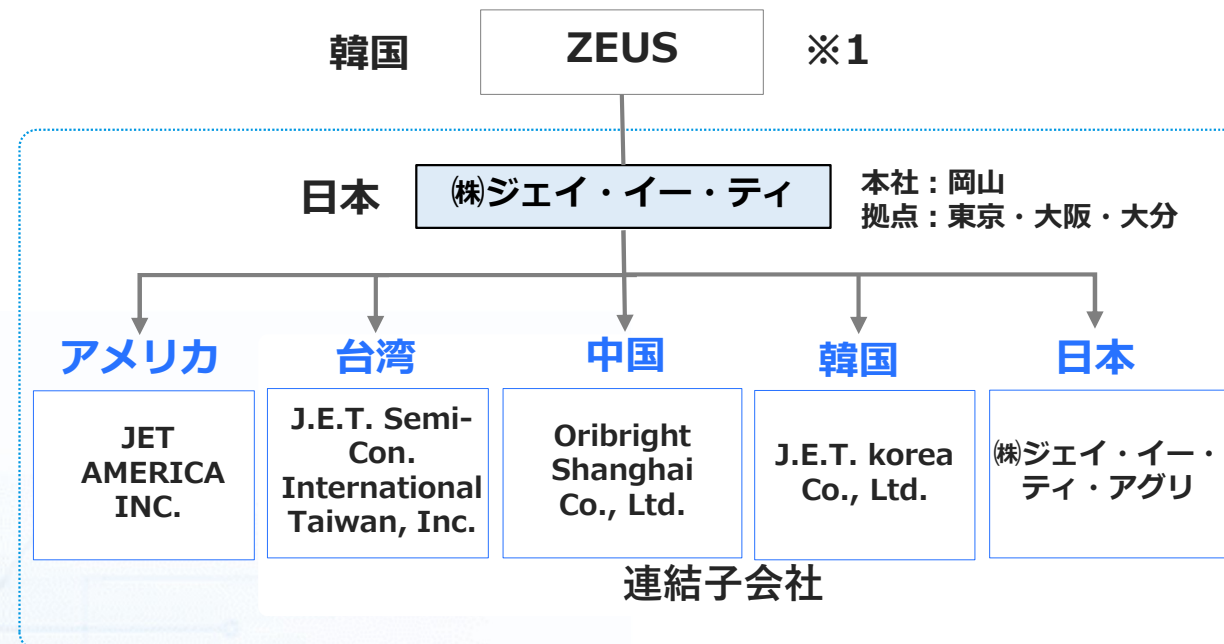
事業の内容： 半導体・液晶用各種製造装置の製造・販売

当社の議決権の保有割合(%)： 66.3%（直接）

関連当事者との関係： 営業取引

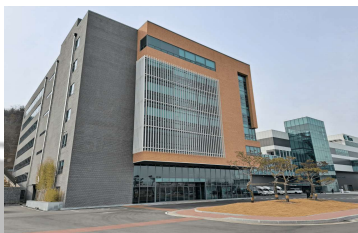
取引の内容： 双方より部品・材料等の販売・仕入及び装置製造業務委託、当社よりZEUSへ販売手数料支払い等

関係図



* 2022年4月末までは、当社にてZEUSより非常勤取締役1名を受け入れていたが、2022年5月以降、ZEUSから当社への役職員の出向等による受け入れは行っていない。

■ 国内拠点
■ 海外拠点



韓国拠点 19名

J.E.T. korea Co., Ltd.

Oribright Shanghai Co., Ltd. 北京事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 無錫事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 合肥事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 西安事務所

Oribright Shanghai Co., Ltd. 広州事務所

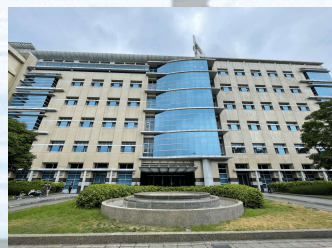
Oribright Shanghai Co., Ltd. 上海本社



中国拠点 69名

* 中国拠点については、一部の事務所の掲載を省略しております。

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(HEAD Office) 台湾本社



台湾拠点 21名

J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc.
(Singapore branch) シンガポール支社

シンガポール 3名

大阪事務所(※2)

東京事務所(※1)

九州出張所(※1)

(株)ジェイ・イー・ティ

- 本社
- 笠岡ファーム(※1)

本社 (岡山)



- ※1 東京事務所及び九州出張所では、当社顧客へのフィールドサービスを提供。
- ※2 大阪事務所は、LIB製品の営業を担当。
- ※3 笠岡ファームでは、当社連結子会社(株)ジェイ・イー・ティ・アグリがトマトを栽培。



JET AMERICA INC.

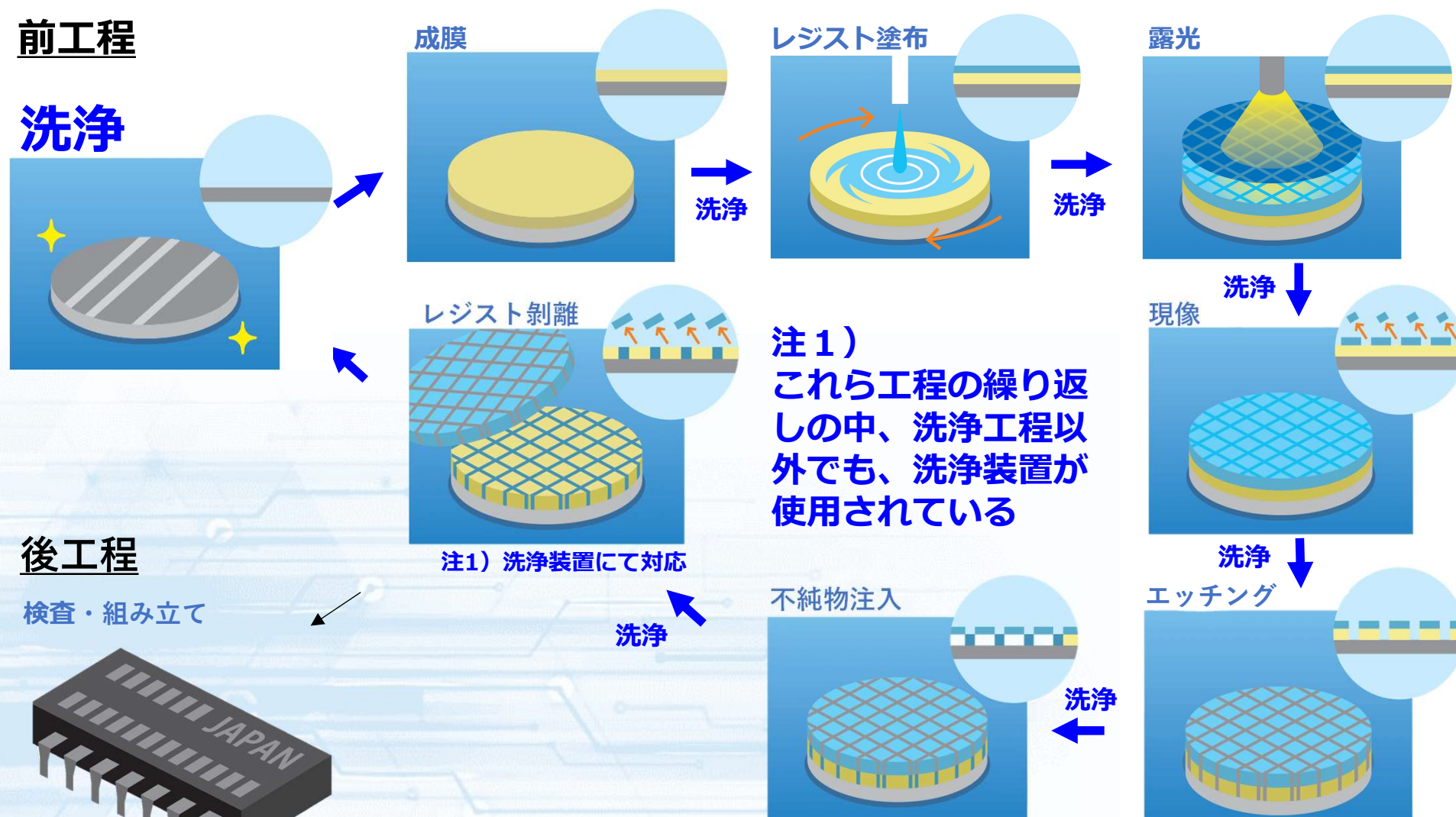
米国拠点 3名

半導体製造プロセス 前工程

半導体製造プロセス前工程（500工程以上）において、洗浄は極めて重要な工程
前工程の30~40%（工程数ベース）が洗浄装置を使用する工程と考えられている

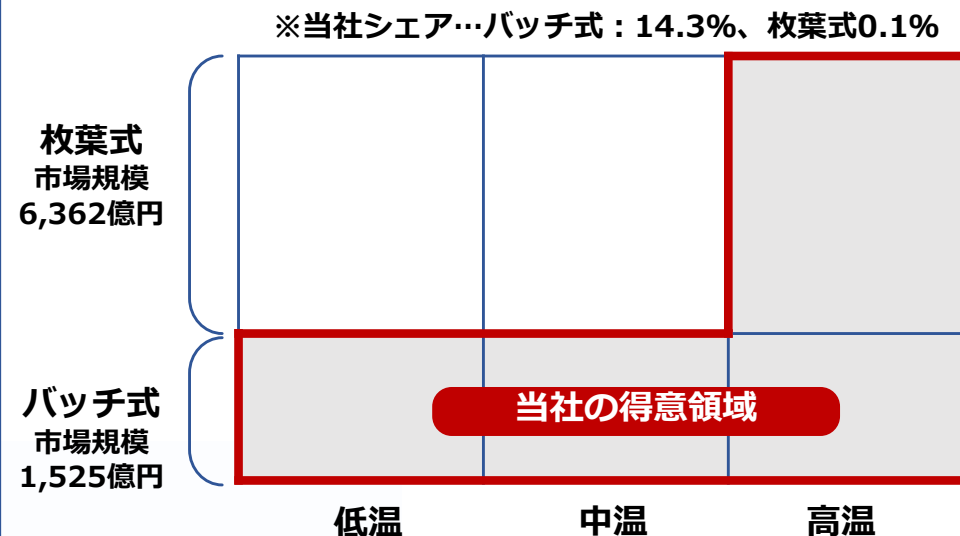
前工程

洗浄



半導体洗浄装置 バッチ式と枚葉式：当社の得意領域

		バッチ式洗浄装置	枚葉式洗浄装置
概要		25～50枚のウエハを一括洗浄	ウエハを1枚ずつ洗浄
長所		生産性が高い	精密な洗浄が可能
短所		ウエハの塵を拾い易い	生産性が低い
現状		生産性の優位性から一定のシェアを堅持	現在の主流洗浄装置
高温高粘度処理	特徴	プロセス温度維持が容易	プロセス温度維持が難しい
	硫酸	○（主流）	△（一部対応）
	リン酸	○（主流）	×（対応なし）
市場規模（2023/世界）		1,525億円 （当社シェア 14.3%）	6,362億円 （当社シェア 0.1%）



競合状況と差別化要素

半導体洗浄装置は、2000年代以降日本企業が70%以上のシェアを持つと考えられており、特にA社、B社の存在感が大きい

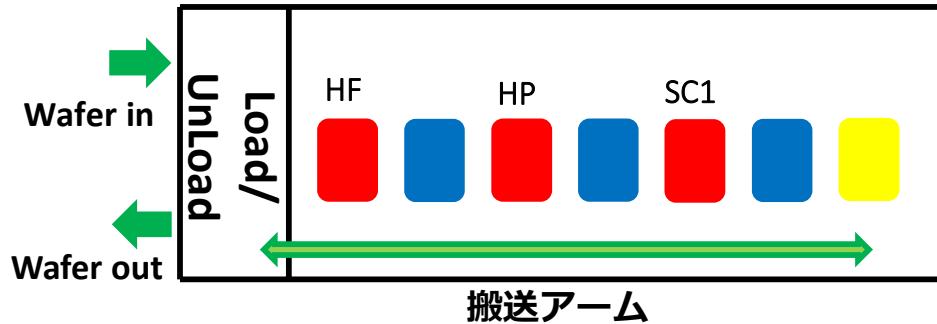
		当社	A社	B社
会社規模 (2023年度 売上高/営業利益)		250億円 (26億円)	5,049億円 (941億円)	1兆8,305億円 (4,562億円)
シェア (2023年度の 市場規模)	バッチ式 (1,525億円)	14.3% (218億円)	49.3% (752億円)	21.6% (329億円)
	枚葉式 (6,362億円)	0.1% (4億円)	47.3% (3,007億円)	20.7% (1,318億円)
技術	RCA洗浄	△	◎	○
	硫酸洗浄	◎	○	△
	リン酸洗浄	◎	○	△
	その他	○	△	○
生産能力		△ (量産能力は低い)	◎ (量産能力あり)	◎ (量産能力あり)
カスタマイズ性		◎ (カスタマイズ性に強み)	△ (標準化装置に強み)	△ (標準化装置に強み)

(出所) 経済産業省「令和5年6月 半導体・デジタル産業戦略」より、評価は当社独自の認識

- 当社の競合他社は、売上規模が数千億円～数兆円の大企業で、高品質で標準化した装置を量産できる点が強み
- 当社は量産能力に劣るものの、難易度の高い高温高粘度処理やカスタマイズ性の高さに強みがある
大企業が参入しづらいニッチ領域へ、小回りの利く当社が参入し、シェアを獲得している状況

JETバッチ装置の優位性⇒ 唯一F-Typeを持つ

I-Type A社 / B社 / 当社

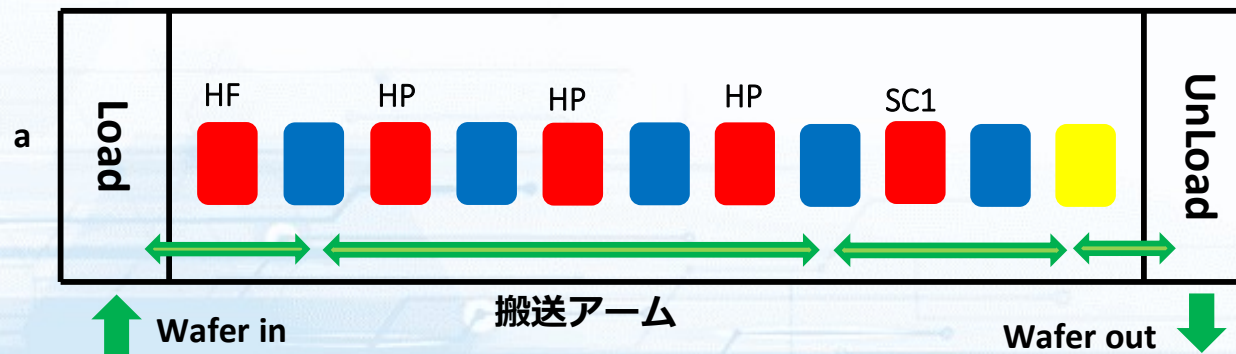


 ケミカル槽
 水洗槽
 乾燥機

特徴

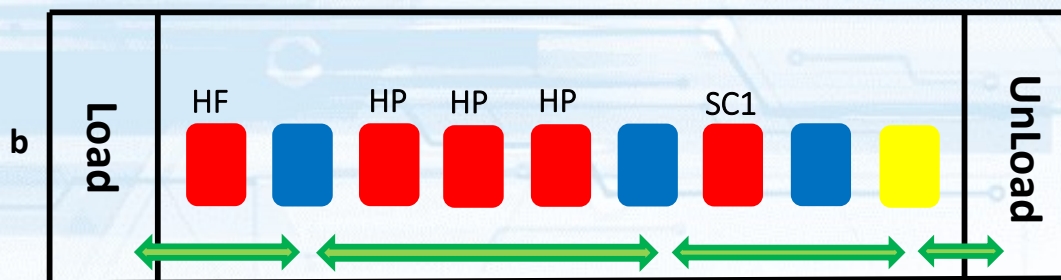
- ・ コンパクト
- ・ 処理槽 MAX 8 槽
(アームが左右に動き、渋滞が発生する為)
- ・ スループット 最大250w/h

F-Type 当社のみ



特徴

- ・ 少し大きい
- ・ 処理槽 MAX14槽
(アームが一方通行で、渋滞なしの為)
- ・ a/b 選択可能
- ・ bはケミカル槽を連続配置可能
- ・ 高温の硫酸・リン酸洗浄に多用
- ・ スループット 最大 500w/h



* 2023年12月時点での当社独自の認識による。

	BW3000	BW3700
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応	バッチ式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（洗浄槽の配列、数量を任意に対応可能） ◎生産効率の向上 ◎500WPHに対応する高速LD/ULD ◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎二酸化炭素の低減 ◎気体流量のコントロールを実現 ◎標準化仕様化を進め、立上タイム短縮 ◎SEMI standardに対応 ◎EES（EDA or TDI）に対応	◎装置設置面積が小さく、工場内への設置数を増やすことが可能 ◎排気システムの個別配管により各処理槽の処理能力を安定化 ◎ウエハ間ピッチ7mm処理の実現 ◎ウエハの接触部の縮小化の実現によるパーティクル（微細なゴミ）の発生を減少 ◎気泡発生の低減化を実現 ◎リバースフローシステムにより液置換効率を向上 ◎濃度の安定性を向上 ◎豊富な処理槽種類に対応 ◎1薬液プラス1DIW構成に対応
価格帯 (平均単価) (百万円)	210~400	320~560

当社主要製品②

	BW2000	HTS-300
		
洗浄方式	バッチ式洗浄装置 200mmウエハ対応	枚葉式洗浄装置 300mmウエハ対応
特徴	◎高い生産効率 ◎高い洗浄能力 ◎省フットプリント ◎顧客要求に応えるフレキシブルな構成（処理槽の構成、数量の変更に対応）	◎最小150ccの薬液消費量での処理を実現 ◎最高240℃での高温処理を実現 ◎最短30秒でのストリップ処理を実現 ◎ウエハ反転処理によるヒューム（薬液の蒸気）拡散防止の実現
価格帯 （平均単価） （百万円）	150～210	330～540

当社主要製品③ BW3500

主力機種BW3000が開発から20年を経過、より顧客ニーズに応えられる後継機種として、BW3500を開発

- 今後投資の中心になる28nm以上のプロセスをターゲットに
- RCA洗浄の他社製品からの切替を意識

BW3000からの改善点

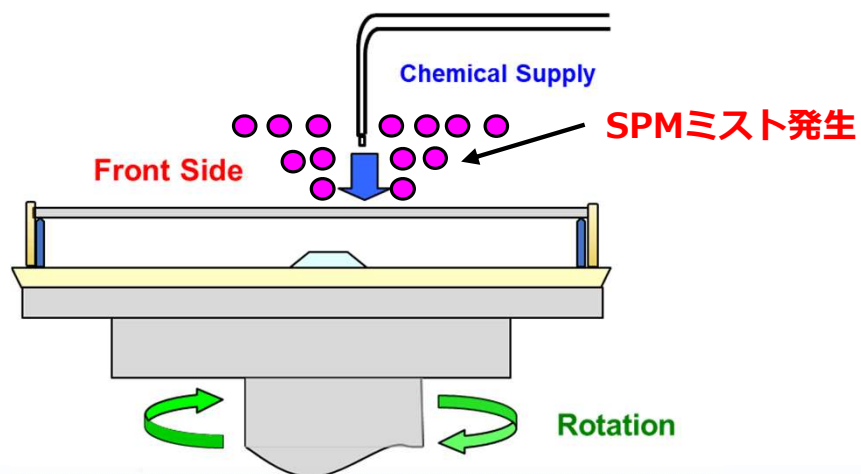
1. フットプリントの削減
(装置面積にて15～16%、装置全長で20%の削減)
2. 新たな搬送方式の採用
(搬送アームに加え、Moving/Single Liferによる搬送)
3. 環境・安全対策
(OHT専用PORTの設置、薬液雰囲気漏れ軽減の機密性向上)
4. 破損防止対策(樹脂槽の採用)
5. 操作性向上(操作画面の大型化、カラー化、情報量アップ)

ほか、ONE BATH、メタルイオン対策、新排気システム、薬液使用量削減、スループット向上、新乾燥システムの採用などを実現



BW3500

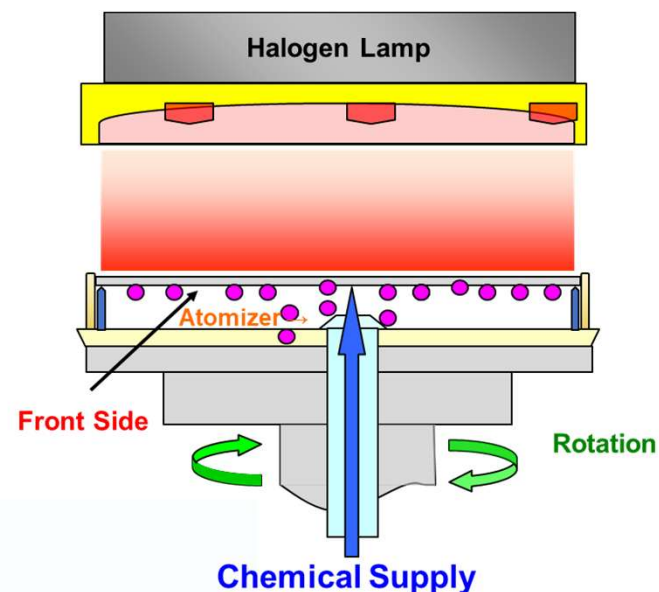
A/B社 枚葉式SPM装置



【他社仕様】

- ・ケミカルの反応熱を利用(150~200℃)
➡ケミカルをかけ続けるも、高温維持は難しい
- ・プロセス時間 : 5 min/Wafer
➡必要ケミカル量 : 3000ml/Wafer
(5分間ケミカルをかけ続ける必要がある為)
- ・SPMミストによりパーティクル発生量が多い

当社 枚葉式SPM装置 (HTS-300)



【JET仕様】

- ・ハロゲンランプにて昇温(200~240℃)
➡高温維持が容易
- ・プロセス時間 : 0.5min/Wafer
➡必要ケミカル量 : 150ml/Wafer
(他社の約20分の1の使用量)
- ・処理面を反転し、霧状にしたケミカルを使用することで
SPMミストが拡散せず、パーティクルの発生量を抑制

本資料の取扱上の注意

- 本資料は、2025年8月8日発表の決算短信に基づいて作成されています。
- また、本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度などの変化により、大きく見通しが変動する可能性があります。
- 本資料に記載しております数字につきましては、単位未満切り捨てで処理しております。また、比率は四捨五入しております。

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社ジェイ・イー・ティ
経営戦略部

TEL 0865-69-4281